# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-204809

(43)Date of publication of application: 29.11.1983

(51)Int.CI.

CO1B 21/064 // B01J 3/08

(21)Application number: 57-083286

(71)Applicant : INOUE JAPAX RES INC

(22)Date of filing:

(72)Inventor: INOUE KIYOSHI

# (54) PREPARATION OF CUBIC BORON NITRIDE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prepare safely, easily and continuously a cubic boron nitride (BN) in high purity, by generating an impact pressure in a mixture of a simple hexagonal BN powder or further containing a fine powder of a catalyst with a pressure transmission fluid by an intermittent electric discharge in a pressure vessel.

CONSTITUTION: Hexagonal boron nitride (BN) powder in a simple substance or further containing one or more catalyst powders selected from Si, Al, Mg, Sb, Li, Cu, Ag, Sn and Pb is mixed with a pressure transmission fluid, e.g. transformer oil, and the resultant mixture is then filled in a pressure vessel. The vessel is then closed to generate an intermittent electrical discharge in the mixture, apply an impact pressure thereto and prepare the aimed cubic BN.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭58-204809

⑤Int. Cl.³
 C 01 B 21/064
 // B 01 J 3/08

識別記号

庁内整理番号 7508-4G 6639-4G ❸公開 昭和58年(1983)11月29日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 8 頁)

# ∮の立方晶窒化ホウ素の製造方法

②特

頭 昭57-83286

②出·

願 昭57(1982)5月19日

@発 明 者 井上潔

東京都世田谷区上用賀3丁目16

番8号

①出 願 人 株式会社井上ジャパックス研究

所

横浜市緑区長津田町字道正5289

番地

四代 理 人 弁理士 最上正太郎

明和音

#### 1. 発明の名称

立方基度化ホウ素の製造方法

- 2) 上紀圧力伝達媒体液に体積比で約32%ペ キテゴナル食化水ウ素粉末を含ませた特許請求の 観囲第1項記載の立方品容化水ウ素の製造方法。
- 3) ヘキサゴナル塩化ホウ素粉末を圧力伝達能体液と混合し、鉄張合物耐圧容器中に充業密閉し 表る後、上記混合物中において、少なくともシリ

コン、アルミニウム、マグネシウム、アンデマン、リチウム、網、網、網及び鉛から成る群の中から 選択された少なくとも一種親以上の元素を合む合 会によって構成される電極を用いて放電を生じせ しめることにより、上記混合物に衝撃圧力を加え ることを物徴とする立方品食化ホウ素の製造方法

- 4)上記属合物が体積比で約32%へキテゴナル窒化水の素粉末を合む特許請求の範囲第3項記 ※のウカ馬変化水の素の製造方法。
- 5)上記電板がアンチモン約30%、46約10 %及び約約10%を含む執許請求の報酬第3項又 は第4項記載の立方基変化ホウ素の製造方法。

本発売は変化すり素、特に立方品変化ホウ素の 製造方法に関するものである。

ニューセラミックの内の一つである食化ホウ素 は別名「白い黒餡」と呼ばれ、セラミック材料の 中では機械加工が容易に行なえる唯一の材料であ

食化水り素は天然には存在しない人工鉱物であ

従って、上記の如き特性を生かし、特殊治其、 るつは、高热(治会)工意関係の耐熱・耐蝕部材 及び原子炉関係の部品等に使用されている。

室化ホりまには立方品、六方品、 ウルツ鉱及び 庭園体品の四種類があるが、特に、 立方品室化ホ り象等はダイヤモンド類似型結晶構造を有し、 ダ イヤモンドに次いで硬い上、 熱的・ 化学的性質 は ダイヤモンドよりも優れているという特徴を持っ ているため、新規な研謝材等として脚先を浴びて いる。

従来、立方品館化水り素は大方品館化水り素な

(3)

り集を取料として衝撃圧縮すると大方品の変形標 途であるウルツ鉱になってしまうので、 触媒を使 用しない衝撃圧縮法では、 変面体品 窒化ホウ 最を 原料として使用する方が良好であるということが 発見された。

この製造方法では、変質体品に鉄や解粉を熱・圧力線体として混ぜた後、ステンレス製のカブセルに入れ、上記カブセル内に爆発による衝撃技を加えて製造するものであり、この際の圧力は瞬間的なものであるが、約100kパールから約1500kパールに適し、触能法の約20ないし約30倍の超高圧力になっている。

想しながら、上記方法では従来からの問題点、即ち、純度が高く、触線からの不純物の混及等等なくすということは解決されたが、爆集の瞬間間を正力を利用するため危険であり、また、一頭科のに爆撃を行わなければならず、更に原うにできた。 して変更の体験室に行うことができないという問題点があった。 特開昭58-204809 (2)

どには、編、リチウム、マグネシウムなどの触線を作用させ高圧条件下で変図体品化して製造するのが一般的な方法であった。然しながら、この方法では、結晶中に不安定ホウ化物や遊離ホウ素などが不純物として混入し、独皮が低下する等の関係点があった。

上記問題点を解決するために触載を改良し、六方品に、アルカリ土類金属ホウ素産化物の復合化合物 (触線)を作用させて、約5°0000気圧、約1450で一約2000での高級高圧下で合成する方法が開発された。この方法によると従来よりも純皮が高く数径が約0.15m程度の結晶をつくることも可能になったが、触線からの不純物の温しは減けられなかった。

西して、昨今、上記触媒を使用しない方法が開発された。この方法は従来の触媒法が静的高圧をかけるのに対して、新方法は傷免(または圧縮空気)という動的高圧力をかけて行うものである。 また、立方基をつくるには大方品質化ホウ素を原料とするのが普通であったが、上紀六方品質化ホ

(4)

くともシリコン、アルミニの、経及び鉛的のでは、マグネンのから、ない、経及び鉛的の元をは、ない、経及び別とのでは、ない、ないないのでは、ないないでは、ないので

以下、図面により本発明の詳細を具体的に説明する。

第1回は本発明にかかる立方品食化率り急を製造するために使用する装置の一実施例を示す説明図、第2回は放電電線の一実施例を示す影明図、第3回及び第4回は他の実施例を示す説明図である。

まず、第1団より以明する。

第1図中、1は高耐圧、耐熱反応容費、2はその宣体、2gは上記宣体2に設けられている空気

(7)

上記反応榜 1 内には水、又はトランス物等の圧力伝達版体核 1 0 が満たされていて、その中にはヘキラゴナル変化ホウ素粉末 1 0 b 及びシリコン、アルミニウム、アンチモン、リチウム、 網、銀、銀及び鉛から選択された少なくとも一種 銀又は二種 銀以上の触媒体の数約 1 0 a が所定の割合で充分混合されている。

第2回は的紀放電電線11の一実施例を示す回路構成図であり、11Aは所定の高電圧を育する 直波充電電線、11bは所定の静電容量及び作動 電圧を育するコンデンサバンクで開閉制御される 充電スイッチ11c及び充電回路インピーダンス 特開昭58-204809(3)

なら、3 はその役、4 及び5 は対向放電電極、6 を及び7 は絶縁ブッシュ、8 及び9 は電極4、5 りに は を がっかっていない 5 は で かっかっていない 5 は で かっといる 5 は で かって 5 は 1 3 は 上 に 電 を 1 3 は 上 に 電 を 1 3 は 上 に 電 で 5 は で 5 は 1 3 は 1 5 に で 5 は 1 5 は 1 5 に

面して、反応容器 1 は軟体の硬質金属火はこれ に関する部材で製作されていて、その内部には一 対の電極 4 及び 5 が電極 取り付けナット 8 及び 9 によって絶縁ブッシュ 6 及び 7 に取り付けられて いる。そして図示してないが、電極 4 及び 5 は、 好ましくは耐積発性の電極材、例えば A 8 ー w、

(8)

11 dを介して充電され、安全スイッチ又は安全スイッチ療放電船数スイッチ11 eを介して充電電荷を電極 4及び 5 間の電極関階に放電エネルギとして放出し、放電部近傍を高温にすると共にその付近又は容器 1 内混合物全体を衝撃的高圧力状態とする。

上の高圧状態となるように加圧密閉するのである。 上記電極4及び5の関階には電響111から供給された電圧により、両電極4及び5期に介在混合物を介して放電が発生し、上配放電によって不足反応容易1内の加圧密閉された前配混合物単圧力と放っまりよの機を受け、この放電循単圧力と熱との作用によって立方晶金化ホウ素が形成されるのである。

例えば、トランス油10中に平均的3μm ≠のヘキサゴナル食化ホウ素を体験比で的23%混入し、更に、適宜に上記シリコン等の触媒体のうちから選択された少なくとも一種類以上の触媒体的1μm ≠のものを約3%を混入させて、0.5μPのコンデンサを放電電圧を約1300 V、パルス幅を0.2 m sec 及びその類接数が約4階で放電を生じせしめた時、立方品質化ホウ素(格子常数が2.504)を15人)を重量百分率で24%、ウルツ型資化ホウ素(格子常数が2.504)を6

(11)

独い放電衝撃圧力と放電間階近傍に於ては放電コラムの高温及び電極4mの消耗に伴う触媒体の操小粉末、又は銀小溶験粉末としての供給を受け、この放電衝撃圧力、熱及び介在触媒の作用によって立方晶質化ホウ素が生成される。

特に、上記電極 4 a を アンチモン 3 0 %、 線を 6 0 %及び船 1 0 %の合金で製作し、トランス市中に体験比で 3 2 %、約 3 μm ≠ のペキサゴナル 食化ホウ素を混入させ、一方、コンデンサ容 動 0.5 μP、 放電電圧を約 1 3 0 0 V、パルス幅を 0.2 m a a c 及びその放電線 り返し期線 飲が約 4 低で放電を生じせしめた時、立方編章化ホウ素(格子常数が 2.55)を重量百分率で 4 6 %、ウルッ型室化ホウ素(格子常数が 2.55)を重量百分率で 1 8 %、ヘキサゴナル室化ホウ素 (格子常数が 2.504)を 3 6 % それぞれ得ることができた。立方編章化ホウ素は約 0.01~ 1 μm ≠ であった。

次に、第4回について裁引する。

第4図中、第1図、第2図及び第3図と同一の 番号を付したものは同一の構成要素を示しており、 特開昭58-204809 (4)

4 %それぞれ得ることができた。立方温度化ホウ 最は約0.01~1 μm∮であった。

次に、多3回について説明する。

第3四中、第1回及び第2回に付した番号と同一の番号を付したものは同一の構成要素を示しており、4 a はシリコン、アルミニウム、マグネシウム、アンチモン、リチウム、類、額、額及び鉛等のうちから選択された少なくとも一種類以上の触媒体を含む嵌系合金、又はその他の合金によって構成されている電極である。

而して、ヘキサゴナル宣化ホウ素粉末10b及び適宜に他の解体が混入された圧力伝達媒体被10を反応容易1内に入れ、第1回の装置の場合と同様に、上記混合物内に含まれている空気を被きつつ遺体2を締めた後、電極4a及び5間に所定の極性、例えば電極4aを正極とする放電電圧をコンデンサ11か6供給する。

上記電極4 a 及び 5<sup>32</sup>は電原11から供給された 電圧により、質電極4 a 及び 5 間に放電が発生し、 上記放電によって反応額1内に密閉さた混合物は

(12)

1 a は反応権 1 に扱けられている空気抜き、 1 4 は重体、 2 に連絡された袖圧 シリング、 1 4 a はピストン1 4 b はピストンロッド、 1 5 は 4 ポート 2 位置切り換え弁、 1 5 a はソレノイドコイル、 1 5 b はスプリング、 1 6 は 抽ポンプ、 1 7 は 抽タンク、 1 8 はコンデンラ、 1 9 は 直流 電器 、 22 はダイオード、 2 1 は主電器スイッチ、 2 2 は 図示されていないシーテンス制御等の制御装置によ制御されるリレー接点である。

而して、袖圧シリンダ14は抽ポンプ16からの抽か4ポート2位置切り換え弁15を介して供給され、袖圧シリンダ14内のピストン14aは4ポート2位置切り換え弁15の切り換えに伴って往復動する。従って、ピストン14aに接続されているピストンロッド14bもピストン14aの往復動に伴って同様に連動する。

反応容器 1 内には、ヘキサゴナル変化ホウ素粉末 1 0 b とシリコン、アルミニウム、マグネシウム、アンチモン、リチウム、網、線、線及び鉛等の内から選択された少なくとも一種親以上の触線

(14)

体粉末10a が混入された圧力伝統体10を入れ、然の後、納圧シリンダ14を動作させ、合意体中に会変をするのであるが、この時時のは会変を対する。数は、からはくののは第1回及び第2回に示した数数としたが、 
油圧シリンダ14a によりピストン14 b を駆動して容器1内混合物を散100 k / od 以上の所定の再圧力圧縮性の電圧を供給することによって、 
電艦4及び5回に放電を生じせしめるのである。

一対の電極 4 及び 5 は高電任に光電可能なコンデンサ 1 8 に接続されていて、作業中に主電 2 ス・イッチ 2 1 間じられ、コンデンサ 1 8 が高電圧に光電され、図示されていない制御装置からの指令信より、リレー接点 2 2 か開閉される。

リレー接点 2 2 が閉じられると、一対の電紙 4 及び 5 間に大放電が発生し、反応権 1 内の混合物 油は超高圧になると共に、放電関際部分近待は超 高温となり、この超高圧衡単圧力と熱の作用によ って立方品変化ホッ象が形成される。

本発明は叙上の如く構成されるので、本発明の

特開昭58-204809(5)

独置による時には、ヘキテゴナル官化ホウ景を利用し、楊重や圧縮空気等によることなく、放電を利用することによっ高圧力と高温とを発生させて立方高官化ホウ素を製造することができるので、 安全、且つ遠続的に、しかも大量に製造することができると共に、より純皮の高い立方晶質化ホウ素を得ることがでのである。

(16)

(15)

## . 4. 図質の簡単な説明

第1回は本発明にかかる立方基室化ホウ素を製造するために使用する装置の一実施例を示す設明 図、第2回は放電電線の一実施例を示す函路構成図、第3回及び第4回は他の実施例を示す設明図である。

3 ... ... ... ... ... 空気抜き B、 g ……………取り付けナット 1.1 ……………電差回降 1 2 ……………抵抗 1 4 ………………抽圧シリング 145...... 1 5 …………… 4 ポート 2 位置切り換え弁 1 5 b ··· ··· ··· ··· スプリング 16……………抽ポンプ 18...... 

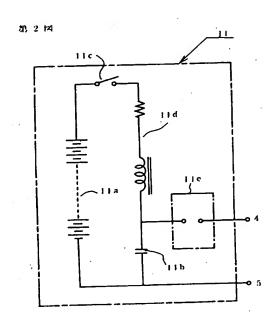
(18).

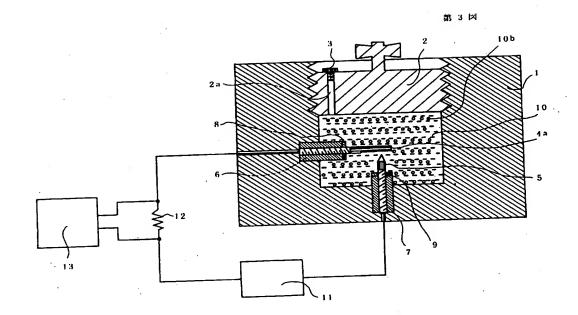
排開站58-204809 (6)

特許出職人 株式会社井上ジャッパックス研究所 代 理 人 (7524) 最 上 正 太 郎

(19)

特開昭58-204809 (7)





# 特開昭58-204809 (8)

